半導体単層カーボンナノチューブの位相緩和時間

甲南大理工^A, 甲南大量子ナノ研^B, 情通機構^C, 産総研ナノテク^D 市田正夫^{A,B}, 齋藤伸吾^C, 宮田耕充^D, 片浦弘道^D, 安藤弘明^{A,B}

Phase relaxation times in semiconducting single-walled carbon nanotubes

Konan Univ.^A, Konan Univ. QNL^B, NiCT^C, AIST^D

M. Ichida^{A,B}, S. Saito^C, Y. Miyata^D, H. Kataura^D, H. Ando^{A,B}

We have investigated third-order nonlinear optical properties of bundled and isolated semiconducting single-walled carbon nanotubes (SWNTs) by means of Z-scan method, and two-beam time-resolved degenerate four-wave mixing (DFWM) method. The figures of merit $\text{Im}\chi^{(3)}/\alpha$ in both bundled and isolated SWNTs samples were found to be enhanced with increasing tube diameter. The measured $\text{Im}\chi^{(3)}/\alpha$ value in the bundled SWNTs was an order of magnitude smaller than that in the isolated SWNTs. The phase relaxation time T_2 for bundled sample were much smaller than those in the isolated sample. The phase relaxation time T_2 is considered to have a significant role in the enhancement of $\text{Im}\chi^{(3)}/\alpha$. We have also investigated the temperature and excitation intensity dependence in the phase relaxation time in order to understand the phase relaxation mechanism.

1. はじめに

単層カーボンナノチューブには、その1 次元性を反映した大きな光学非線形性が 現れる。我々は、ポンプ・プローブ分光 法や Z-scan 法を用いて単層カーボンナノ チューブの光学非線形性について調べて いる。Z-scan 法によって測定した 3 次非 線形感受率の虚部(Im χ⁽³⁾)には強い試料 依存性や直径依存性があることがわかっ ている[1]。単純な2準位モデルでは、 χ⁽³⁾/αは分布緩和時間 T₁および位相緩和 時間 T₂に比例するので、χ⁽³⁾/αの試料依 存性や直径依存性は、これらの緩和時間 の違いによるものだと考えられる。実際、 ポンプ・プローブ法で測定した T₁は、孤 立試料の方が長く、また、直径が大きい チューブほど長くなっており、性能指数 の依存性とその傾向は一致している。し かし、非線形性の測定に用いている励起 レーザーパルス幅は *T*₁よりも短いため、 非線形性の増大に *T*₁が直接関与している とは考えにくい。一方、単層カーボンナ ノチューブでは位相緩和時間が直接測定 された例は、ほとんど無く、その直径や 温度依存性などもよくわかっておらず、 非線形性への寄与も明らかではない。

本研究は単層カーボンナノチューブの 3次光学非線形性の増大の起源を解明す るため、位相緩和時間の測定を行い、そ の試料依存性や温度依存性などを調べた。

2. 実験方法

界面活性剤で単層カーボンナノチュー

ブを孤立分散させたミセル化試料[2]と、 ナノチューブがバンドル化している薄膜 試料を用いた。また、ミセル化試料をポ リマー中に分散させた試料を用いて、位 相緩和時間の温度依存性を測定した。ミ セル化試料と薄膜試料の吸収スペクトル を図 1 の実線で示す。半導体第一遷移吸 収帯が 0.6~1.1eV に観測できる。

3次の非線形感受率 $\chi^{(3)}$ の測定はZ-scan 法で行った[3]。 $\chi^{(3)}$ の値を精度よく測定 するために、二硫化炭素との相対測定を 行った。位相緩和時間 T_2 の測定には2ビ ーム入射型時間分解四光波混合法 (DFWM)を用いた[4]。励起光源には繰り 返し1 kHz のチタンサファイア再生増幅 器と OPA を用いた。パルス幅は Z-scan 法 では約 150fs、DFWM 法では約 50fs であ る。

3. 結果と考察

3-1. 試料依存性



図 1: ミセル化試料(Isolated)と薄膜試料 (Bundled)の吸収スペクトル。〇●は性能 指数-Im $\chi^{(3)}/\alpha$

図 1 の〇および●は、Z-scan 法で測定 した 3 次非線形感受率の虚部 Im χ⁽³⁾を吸 収係数 α で割った、いわゆる性能指数で ある。ミセル化試料、薄膜試料共に、低 エネルギー側で性能指数が大きくなって いる。これは、直径が大きなチューブほ ど大きな非線形性を持っていることを示 している。また、同程度の直径で性能指 数を比較すると、ミセル化試料の方が薄 膜試料に比べて一桁程度大きな値になっ ていることがわかる。これは、ミセル化 することによりチューブが孤立化してチ ューブ間の緩和が無くなり、寿命が長く なったことがその原因と考えられる。ポ ンプ・プローブ法でこれらの試料の有効 寿命 T₁を測定したところ、薄膜試料では 2ps 程度、ミセル化試料では 5ps 程度であ り、ミセル化試料の方が寿命は長い[5]。 しかし、性能指数での増大に比べるとそ の比は小さく、T₁が非線形性の増大に直 接寄与しているとは言い難い。

次に、これらの試料で位相緩和時間の 測定を行った。図2に、 k_1 および k_2 方向 の励起光パルスに対して $k_3=2k_2-k_1$, $k_4=2k_1-k_2$ 方向に出力されるDFWM信号の 時間発展を示す。横軸は励起光パルスの 時間間隔である。励起光パルスの幅が位 相間時間に比べて十分に短い場合には、 信号は、

$$I_{\rm DFWM}(t_2 - t_1) = A \exp(-\frac{t_2 - t_1}{\tau})$$

となり、指数関数的な減衰を示し、その 時定数から位相緩和時間を見積もること が出来る[4]。しかし、測定された信号に は指数関数的な減衰挙動は見られない。 これは、位相間時間と励起光パルスの幅 が同程度であるためである。





測定された DFWM 信号は、 k_3 方向と k_4 方向の信号のピークが時間原点からずれ ている。図 2 の測定結果では、ピーク間 の時間間隔 τ_s はミセル化試料では 60fs、 薄膜試料では 20fs である。この時間間隔 τ_s から位相緩和時間を見積もることが出 来る[6]。この系が不均一広がりの系だと 仮定すると、ミセル化試料では位相緩和 時間 T_2 は 90fs であり、薄膜試料では 20fs と見積もられる。この位相緩和時間の違 いが、非線形性の性能指数の違いとして 現れていると考えられる。

3-2. 励起光強度依存性

図 3(a)に位相緩和時間の励起光強度依存性を示す。どちらの試料でも励起光強度の増大と共に、位相緩和時間が短くなっていることがわかる。緩和レートをあらわす均一幅 Γ_h と位相緩和時間 T_2 の間には、

 $\Gamma_h = \frac{2\hbar}{T_2}$

の関係がある。図 3(b)に、均一幅の励起 光強度依存性を示す。均一幅は励起光強 度に対して線形に増大している。緩和レ ート Γ_h は、温度、直径、励起光強度およ び試料に依存するとすると、 $\Gamma_h(d,T,n_{ex})$

= $\Gamma_0 + \Gamma_{ex-ph}(d,T) + \Gamma_{ex}(n_{ex})$ と書くことができる。ここで、 Γ_0 は欠陥 や凝集状態など試料で決まる成分、 $\Gamma_{ex-ph}(d,T)$ は直径と温度に依存する励起 子・格子相互作用による成分、 $\Gamma_{ex}(n_{ex})$ は 励起子密度に依存する成分である。励起 子密度は励起光強度 I_{ex} に比例するとする と、 Γ_h を計算することができる。松田ら は顕微 PL による単一チューブの均一幅 の励起光強度依存性を Auger 過程による 励起子の緩和で説明している[7]。1 次元 系での Auger 過程の場合には $\Gamma_{ex}(n_{ex})$ は、

$\Gamma_{\rm ex}(n_{\rm ex}) = \gamma_{\rm Auger} n_{\rm ex}^2$

であらわされ、励起子密度 n_{ex}の2 乗に依存する[8]。一方、励起子・励起子散乱の



図 3: 位相間時間および均一幅の励起光 強度依存性。○はミセル化試料、●は薄 膜試料の結果。

場合には、

$$\Gamma_{\rm ex}(n_{\rm ex}) = \gamma_{\rm ex-ex}n_{\rm ex}$$

であり、励起子密度に比例する[9]。実験 結果は図 3(b)の実線で示されるように、 励起子・励起子散乱による緩和過程を支 持している[10]。

3-3. 温度依存性

図4は、ポリマー中のミセル化ナノチ ューブの位相緩和時間と均一幅の温度依 存性である。温度上昇とともに位相緩和 時間が短くなっている。一方、均一幅は 温度に対して線形に増大していることが わかる。この結果は、位相緩和時間、す なわち均一幅の温度依存性が、小さなエ ネルギーの音響型フォノンによる励起子 のバンドない散乱によるものであること を示唆している[10]。同様の結果は、PL の測定結果から報告されている[7]。

4. まとめ

縮退四光波混合法により半導体単層カ ーボンナノチューブの位相緩和時間を測 定した。チューブが孤立化しているミセ



図4:ポリマー中ミセル化チューブ試料 の位相緩和時間○と均一幅●の温度依 存性

ル化試料ではバンドル薄膜試料に比べて、 位相緩和時間が長い。これが、ミセル化 チューブでの非線形性の増大に寄与して いると考えられる。位相緩和時間には励 起光強度依存性があり、励起子・励起子 散乱による位相緩和レートの増大が原因 であると考えられる。また、位相緩和時 間の温度依存性は、音響フォノンによる 励起子のバンド内散乱で説明される。

<参考文献>

M. Ichida, Y. Kiyohara, N. Ueda, Y. Miyata, H. Kataura, S. Saito, and H. Ando, AIP Conf. Proc. 893, 451 (2007).

[2] S. M. Bachilo, M. S. Strano, C. Kittrell, R.H. Hauge, R. E. Smalley, R. B. Weisman, Science 298, 2361 (2002).

[3] M. Sheik-Bahae, A. A. Said, T. H. Wei, D.J. Hagan, and E. W. Van Stryland, IEEE J.Quantum Electron. 26, 760 (1990).

[4] T. Yajima and Y. Taira, J. Phys. Soc. Jpn.47, 1620 (1979).

[5] M. Ichida et al., unpublished.

[6] A. M. Weiner, S. De Silvestri, and E. P. Ippen, J. Opt. Soc. Am. B 2, 654 (1985).

[7] K. Matsuda, T. Inoue, Y. Murakami, S. Maruyama, and Y. Kanemitsu1, Phys. Rev. B 77, 033406 (2008).

[8] F. Wang, Y. Wu, M. S. Hybertsen, and T.F. Heinz1, Phys. Rev. B 73, 245424 (2006).

[9] A. Honold, L. Schultheis, J. Kuhl, and C.W. Tu, Phys. Rev. B 40, 6442 (1989).

[10] M. Ichida, Y. Kiyohara, S. Saito, Y. Miyata, H. Kataura, and H. Ando, phys. stat. sol. (b), (2008), in press.